

Тематический указатель статей, опубликованных в 2010 году

Фундаментальные исследования

Гончаров В.А., Азанова И.В., Васекин Б.В. Модель неравновесной кристаллизации для численного решения задачи роста полупроводниковых кристаллов из расплавов. №5(85), с. 5.

Данилов А.А., Терещенко С.А., Пьянов И.В., Гавриков А.И. Определение коэффициентов поглощения и рассеяния сильнорассеивающих сред на основе измерений временных распределений интенсивности лазерных импульсов. №4(84), с. 3.

Лавров И.В. Эффективная проводимость поликристаллической среды. Одноосная текстура и двуосные кристаллиты. №3(83), с. 3.

Мороcha А.К. К теории волн Лява в гетероструктурах с гексагональной симметрией. №1(81), с. 3.

Материалы электронной техники

Яремчук А. Ф. Контроль качества кремниевых слитков методом спада фотопроводимости. №6(86), с. 3.

Технология микроэлектроники

Багшский И.Л., Косцов Э.Г. Обратимый быстродействующий «электростатический клей». №2(82), с. 18.

Белов А.Н., Гаврилин И.М., Гаврилов С.А., Дронов А.А. Особенности морфологии пленок оксида титана, полученных вытягиванием кремниевых подложек из раствора. №6(86), с. 8.

Виноградов А.И., Зарянкин Н.М., Прокопьев Е.П., Тимошенко С.П., Михайлов Ю.А. Оптимизация параметров процесса глубокого плазмохимического травления кремния для элементов МЭМС. №2(82), с. 3.

Гаврилов С.А., Железнякова А.В., Редичев Е.Н., Попенко Н.И. Влияние состава растворов-прекурсоров на оптические свойства пленок In_2S_3 , осаждаемых ионным наслаиванием. №2(82), с. 10.

Горлов М.И., Смирнов Д.Ю., Золотарева Е.А. Влияние рентгеновского излучения на низкочастотный шум ИС. №4(84), с. 8.

Дмитриев А.Н., Чередищенко Д.И. Формирование слоев графена сублимацией карбида кремния в вакууме сканирующим источником тепла. №6(86), с. 12.

Сагунова И.В., Шевяков В.И., Гаврилов С.А., Белов А.Н. Кинетика локального зондового окисления сверхтонких пленок металлов V, Nb, Ta, Ti, TiN, W. №3(83), с. 13.

Тимошенко С.П., Бойко А.Н., Симонов Б.М., Заводян А.В. Технологии вакуумной герметизации МЭМС. Обзор. №1(81), с. 11.

Микроэлектронные приборы и системы

- Бирюков В.Н.* Оценка точности определения параметров моделей полевого транзистора. №5(85), с. 22.
- Галалу В.Г.* Оценка достижимой разрядности базовой схемы преобразователя код-напряжение для гибридного исполнения. №6(86), с. 19.
- Добрынин А.В., Харитонов Т.В., Казаков В.К.* Анализ тепловых процессов в пьезокерамическом актуаторе. №1(81), с. 38.
- Колеров А.Н.* Режимы генерации лазерного импульса, управляемые полупроводниковыми фильтрами. №1(81), с. 30.
- Малашевич Н.И., Росляков А.С., Поломошников С.А., Фёдоров Р.А.* Микросхема для обработки низкочастотного сигнала с сейсмодатчика. №6(86), с. 29.
- Новиков С.Г., Гурии Н.Т., Корнеев И.В.* Моделирование и исследование биполярного транзистора с передаточной N -образной вольт-амперной характеристикой. №4(84), с. 14.
- Орда-Жигулина М.В., Алексеев Ю.И.* Амплитудно-частотное преобразование при СВЧ-модуляции инжекционных полупроводниковых лазеров. №6(86), с. 25.
- Сергеев В.А., Фролов И.В., Широков А.А., Щербатюк Ю.Н.* Вероятностные характеристики электрических шумов гетеропереходных светодиодов. №5(85), с. 15.
- Тимошенко В.П.* Сверхширокополосный трансивер гигагерцового диапазона на SiGe-транзисторах. №3(83), с. 20.
- Тимошенко В.П.* Интегральный эквалайзер гигагерцового диапазона на гетеропереходных биполярных транзисторах. №4(84), с. 20.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Скворцов В.С., Мерданов М.К.* Волноводные фотонные кристаллы с характеристиками, управляемыми $p-i-n$ -диодами. №1(81), с. 24.

Нанотехнология

- Агеев О.А., Алябьева Н.И., Коноплев Б.Г., Поляков В.В., Смирнов В.А.* Фотоактивация процессов формирования наноструктур методом локального анодного окисления пленки титана. №2(82), с. 23.
- Булярский С.В., Пятшлова О.В., Цыганцов А.В., Басаев А.С., Галперин В.А., Павлов А.А., Шаман Ю.П.* Расчет параметров нуклеации кластеров катализаторов для синтеза углеродных нанотрубок. №3(83), с. 38.
- Булярский С.В., Пятшлова О.В., Цыганцов А.В., Басаев А.С., Галперин В.А., Павлов А.А., Шаман Ю.П.* Термодинамика формирования кластеров катализаторов для роста углеродных нанотрубок. №1(81), с. 50.
- Герасименко А.Ю., Губарьков О.В., Ичкитидзе Л.П., Подгаецкий В.М., Селищев С.В., Попомарева О.В.* Нанокompозитный припой для лазерной сварки биологических тканей. №4(84), с. 33.
- Григорашвили Ю.Е., Бухлин А.В., Верюжеский И.В.* Формирование наноразмерных сверхпроводниковых структур с критической температурой выше 100 К. №2(82), с. 32.
- Громов Д.В., Елесин В.В., Петров Г.В., Бобринецкий И.И., Неволин В.К.* Радиационные эффекты в элементах наноэлектроники. №1(81), с. 45.
- Громов Д.Г., Жигальский Г.П., Карев А.В., Карев И.А., Чулков И.С., Шмелёв С.С.* Флуктуационные явления в пленках никеля нанометровой толщины вблизи температуры плавления. №3(83), с. 31.
- Дубков С.В., Гаврилов С.А., Громов Д.Г., Красулин Г.А.* Низкотемпературный процесс формирования углеродных трубчатых и графеновых структур. №4(84), с. 28.
- Руднев А.В., Хлышов А.В.* Механизм электрокристаллизации кобальта на монокристаллах Au(111). №2(82), с. 37.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В.* Электрофизические свойства композитов с включениями углеродных нанотрубок, частиц мелкодисперсного графита и ферритовых микрочастиц. №5(85), с. 28.

Усанов Д.А., Скрипаль Ал.В., Скрипаль Ан.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Али Бакуи. Измерение параметров нанометровых пленок оптическими и радиоволновыми методами. №3(83), с. 44.

Схемотехника и проектирование

Бачманов В.А., Бобриков С.А., Заболотнов И.В. Диакоптические методы временной характеристики статических ЗУПВ КМОП, компилируемых по субмикронным проектным нормам. №4(84), с. 42.

Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Егоров Ю.Б. Статистический анализ сложных функциональных блоков. №5(85), с. 41.

Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Егоров Ю.Б. Методы ускоренной характеристики библиотек элементов СБИС с контролем заданной точности. №3(83), с. 51.

Заглядин Г. Г., Сырцов И. А., Школа А. В. Алгоритм синтеза множества остовных деревьев для выполнения глобальной трассировки заказных СБИС. №5(85), с. 36.

Перминов В.Н., Макаров С.В., Кокин С.А., Веселов А.Е. Использование параметрической оптимизации при проектировании библиотечных элементов СБИС и специализированных интерфейсов нанoeлектронных устройств. №2(82), с. 42.

Эннс А.В. Метод кусочной аппроксимации температурной зависимости источника опорного напряжения. №4(84), с. 52.

Микросистемы

Тимошенко С.П., Бойко А.Н., Симонов Б.М. Методы сборки и монтажа макетных образцов микроэлектромеханических систем. №4(84), с. 58.

Микропроцессорная техника

Беклемишев Д.Н., Переверзев А.Л., Твердунов Д.В. Однокристалльный вычислитель для беспилотного летательного аппарата. №6(86), с. 33.

Беляев А.А. Оптимальная по производительности глубина программного конвейера для приложений с программными переходами и зависимостью по данным. №2(82), с. 48.

Лисов О.И., Махалов А.А. Оценка эффективности двух вариантов реализации диспетчера памяти для ядра архитектуры «Орхидея». №3(83), с. 61.

Штерн Ю.И., Козлевников Я.С., Рыков В.М., Миронов Р.Е., Штерн М.Ю. Разработка математических моделей для интеллектуальных систем управления прецизионным термическим оборудованием. №2(82), с. 52.

Информационные технологии

Амербаев В.М., Балака Е.С. Методы вычисления гауссовых логарифмов N переменных над полем Галуа $GF(p)$. №4(84), с. 64.

Гончаров В.А., Балдина Н.А., Дорошенко Е.С., Подкопаев И.В. Численное моделирование процесса кристаллизации полупроводников с использованием параллельных вычислений. №6(86), с. 49.

Ким А.А. Разработка низкоплотностного сверточного кодера с генератором терминирующей последовательности для пакетной передачи данных. №1(81), с. 63.

Кузнецов В.С., Мордасов К.А. Быстрое декодирование на основе пассивной согласованной фильтрации длинных псевдослучайных кодов. №1(81), с. 57.

Матюшкин И.В., Хамухин А.В. Применение языка UML при проектировании клеточных автоматов. №6(86), с. 39.

Трещановский П.А. Методы управления качеством обслуживания в мультисервисных сетях абонентского доступа. №3(83), с. 68.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Булывчев Ю.Г., Мозоль А.А., Вернигора В.Н. Оперативное ранжирование целей по дальности в комплексах радиоэлектронного подавления по минимальному числу угломерно-мощностных измерений. №1(81), с. 68.

Демьяненко А.В., Алексеев Ю.И. Использование лавинно-пролетного диода для детектирования СВЧ амплитудно-модулированных оптических колебаний. №4(84), с. 70.

Колеров А.Н., Опиценко Д.В., Рухлов Д.С. Многоканальный фотоэлектрический регистратор эмиссионных спектров. №6(86), с. 67.

Кочетков В.Ю. Квазикогерентный алгоритмический демодулятор с подстройкой частоты по информационному сигналу. №2(82), с. 60.

Курганов В.В., Лялин К.С., Приходько Д.В. Построение модели системы встроенного контроля антенных решеток для радиолокаторов с синтезированной апертурой. №5(85), с. 48.

Хвалин А.Л., Игнатьев А.А., Самолданов В.Н. Микрополосковые преобразователи энергии электромагнитного поля на основе сферических ЖИГ-резонаторов. №4(84), с. 75.

Широ Е.Г., Широ Г.Э. Метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях. №6(86), с. 58.

Яремчук А.Ф., Алексеев А.В., Короткевич А.В. Применение коротких световых импульсов для измерения параметров солнечного элемента. №2(82), с. 65.

Методы и техника измерений

Алексеев А.М., Комков В.Н., Краснобородько С.Ю., Шевяков В.И., Шубин А.Б. Особенности методики трехпроходных измерений в магнитной силовой микроскопии. №6(86), с. 63.

Быков В.А., Кузнецов Е.В., Пьянков Е.С. Уменьшение влияния температурного дрейфа в сканирующих зондовых микроскопах. №5(85), с. 58.

Карташов Д.А., Герасименко Н.Н., Медетов Н.А., Турьянский А.Г., Цехош В.И. Эффективность генетического алгоритма при анализе данных рентгеновской рефлектометрии. №3(83), с. 74.

Шадов М.Б. Особенность реализации метода затухания фотопроводимости при измерении рекомбинационных параметров полупроводника. №1(81), с. 75.

Биомедицинская электроника

Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Лазарев В.В. Электронная система тестирования технических характеристик гемодиализных аппаратов. №4(84), с. 80.

Тельшиев Д.В. Алгоритм определения фибрилляции желудочков для автоматических наружных дефибрилляторов. №1(81), с. 80.

Проблемы высшего образования

Баин А.М. Математическая модель системы дистанционного обучения. №2(82), с. 71.

Краткие сообщения

Артамонов Д.С. Метод обеспечения динамической частичной реконфигурируемости аппаратуры высокопроизводительного систолического процессора. №5(85), с. 68.

Аунг Пхио Вин, Трояновский В.М. Сравнение методов обнаружения периодичности стохастических сигналов. №2(82), с. 84.

Гайдуков Г.Н., Жаринова Н.Н. Влияние упругого взаимодействия примесных атомов на их распределение в системе двумерных квантовых точек. №2(82), с. 76.

Гуреев А.В., Миронов Ю.Б. Условие устойчивости мобильной беспроводной сети. №6(86), с. 80.

Егоркина Р.Ю. Модернизация системы мониторинга отходов производства изделий нано- и микро-системной техники. №3(83), с. 90.

Еришов М.Д., Маслобоев Ю.П., Потапов Д.А., Титенок С.А. Модель прохождения ультракороткого лазерного импульса через однородный рассеивающий слой. №6(86), с. 72.

Крупкина Т.Ю., Пьянков Е.С., Алексеев А.А. Улучшение системы позиционирования в сканирующей зондовой микроскопии. №6(86), с. 78.

Крупкина Т.Ю., Родионов Д.В. Анализ распределения заряда в интегральных наноразмерных КМДП-структурах. №4(84), с. 89.

Курина В.В. Оценка эффективности применения дискретного псевдосинусного преобразования для сжатия изображений. №2(82), с. 78.

Локтев Д.В., Красулин Г.А., Зиновьев Д.В. Тепловой микроэлектронный датчик перемещений. №3(83), с. 88.

Морозова Н.В., Смирнов А.В., Чэжи Я Аунг. Коррекция изображения при выводе на печатающее устройство. №1(81), с. 90.

Неустроев С.А. Тетраэдрические связи кубического углерода. №4(84), с. 86.

Николаев А.В. Анализ энергопотребления элементов конденсаторно-транзисторной логики методами приборно-технологического моделирования. №5(85), с. 66.

Новиков С.Н., Тимошенко С.П., Сухоруков Д.О. Зависимость работы выхода электрона от условий окисления Si(100). №3(83), с. 86.

Опаричев Е.Б., Каримбеков М.А., Опаричев А.Б., Вигдорovich В.И. Классификация конструкторско-технологических решений пленочных термоэлектрических преобразователей измерительного назначения. №3(83), с. 79.

Петросяц К.О., Орехов Е.В., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Ятманов А.П. Трехмерное моделирование радиационных токов утечки в субмикронных МОП-транзисторах со структурой кремний–на–изоляторе. №2(82), с. 81.

Петросяц К.О., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Ятманов А.П. BSIMSOI-RAD – макромодель КНИ/КНС МОП-транзистора для схемотехнического расчета КМОП БИС с учетом радиационных эффектов. №5(85), с. 64.

Поголов А.И., Блинов Г.А., Чугунов Е.Ю. Моделирование термочности многокристалльных микромодулей. №5(85), с. 73.

Портинов Е.М., Вин Мьинт Зо. Статическая модель автоматизированного расходомера с жидкостными метками. №1(81), с. 88.

Саркисов А.Ш., Риттер А.В., Саркисов В.А. Измерительный датчик тока с PIC-контроллером. №3(83), с. 82.

Сергеенко В.С. Кодек речи для устройств мобильной связи. №6(86), с. 76.

Соколова Т.Ю. Использование внешних ссылок в среде автоматизированного проектирования. №5(85), с. 71.

Соколова Т.Ю., Руденский Р.В. Компьютерное геометрическое моделирование приборов и устройств электронной техники на базе пакета SolidWorks. №4(84), с. 91.

Хаханян С.Ю. Контроль чистоты реагентов безотходных технологий очистки поверхности полупроводниковых структур методом инверсионной вольтамперометрии. №6(86), с. 74.

Хаханян С.Ю. Методы и средства контроля чистоты реагентов в безотходных технологиях очистки поверхности полупроводниковых структур. №2(82), с. 83.

Щёголева Т.В., Образцов Р.М., Добрынин А.В. Частотные характеристики поддерживающих конструкций биморфного пьезокерамического элемента балочного гироскопа. №3(83), с. 84.

Юбилей

Гаврилов С.А., Рыгалин Б.Н. Научно-исследовательский комплекс МИЭТ. №5(85), с. 85.

Геннадию Георгиевичу Казённову – 75 лет. №2(82), с. 93.

Гуляеву Юрию Васильевичу – 75 лет. №6(86), с. 83.

Жоресу Ивановичу Алфёрову – 80 лет. №2(82), с. 91.

Игнатова И.Г., Матыша Л.И., Хвостик Т.В. МИЭТ – инновации в образовании. №5(85), с. 81.

К 80-летию со дня рождения Малинина А.Ю. №6(86), с. 85.

Чаплыгин Ю.А. МИЭТу – 45. №5(85), с. 77.

Конференции. Семинары. Выставки

Вернер В.Д., Ильков В.К. Инновации – тактика выхода из кризиса (выставка «Продуктроника – 2009», г. Мюнхен, Германия). №2(82), с. 86.

Об итогах 17-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2010». №3(83), с. 92.

Об итогах работы V Международной юбилейной научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, технике и образовании» (22 сентября – 2 октября 2009 г., Республика Абхазия, г. Пицунда). №1(81), с. 93.

Сессия годовичного собрания секции по проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета по новым материалам при Международной ассоциации Академии наук. №5(85), с. 76.

Международная научно-техническая конференция с элементами научной школы для молодежи «Проектирование систем на кристалле: тенденции развития и проблемы» (19–21 октября 2010 г., Россия, г. Москва). №6(86), с. 87.

Памяти Камиля Ахметовича Валиева. №5(85), с. 92.